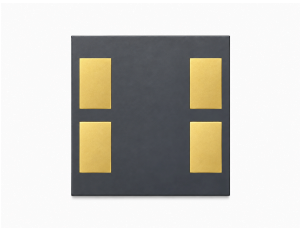
2 × 20 Ω GaAs薄膜电阻裸芯片

LCRES-N2-R20OHM — 2 × 20 Ω GaAs薄膜电阻裸芯片.

电阻值: 20 / 20 Ω (典型值); 线性工作电流: 0.165 / 0.165 A (典型值); 最大承受电流: 0.33 A (最大值). 裸片平面尺寸: 0.5 × 0.5 mm.



电气特性 TA = +25 °C

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
电阻数量	-	-	-	-	2	-
端口数量	-	-	-	-	4	-
电阻值	-	-	20 / 20	-	-	Ω
阻值精度	-	-	±5	-	-	%
线性工作电流	-	-	0.165 / 0.165	-	-	A

极限参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
最大承受电流	-	-	-	0.33	A

环境参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
储存温度	-	-65	-	150	°C
工作温度	-	-55	-	125	°C

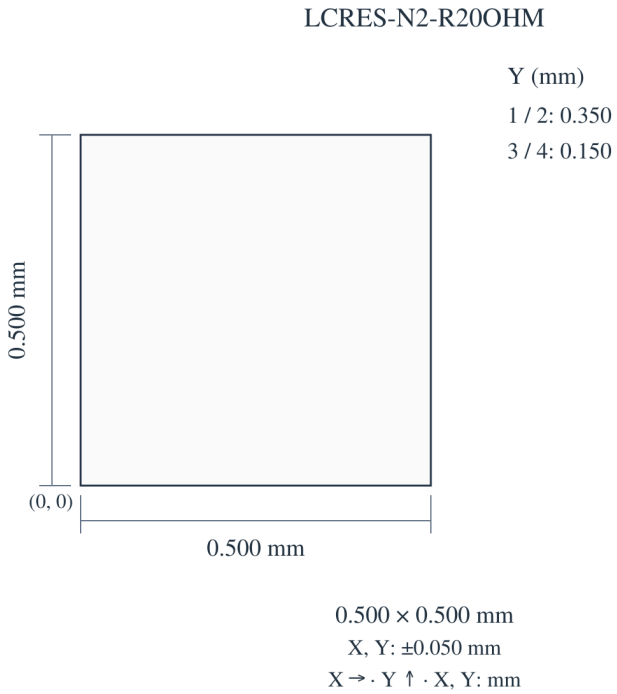
压点定义

序号	功能符号	功能	说明
1, 2	IN1/OUT1	互易输入/输出	1
3, 4	IN2/OUT2	互易输入/输出	2
芯片背面	GND	接地	RF / DC GND

裸片尺寸

参数	数值	单位
裸片平面尺寸	0.5 × 0.5	mm

尺寸参考图，单位为 mm。图中列出部分尺寸，制造和引线键合须参照完整图纸。



当前出版记录 · 1.3 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.2.

裸片集成与偏置时序

芯片背面需要可靠接地。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。